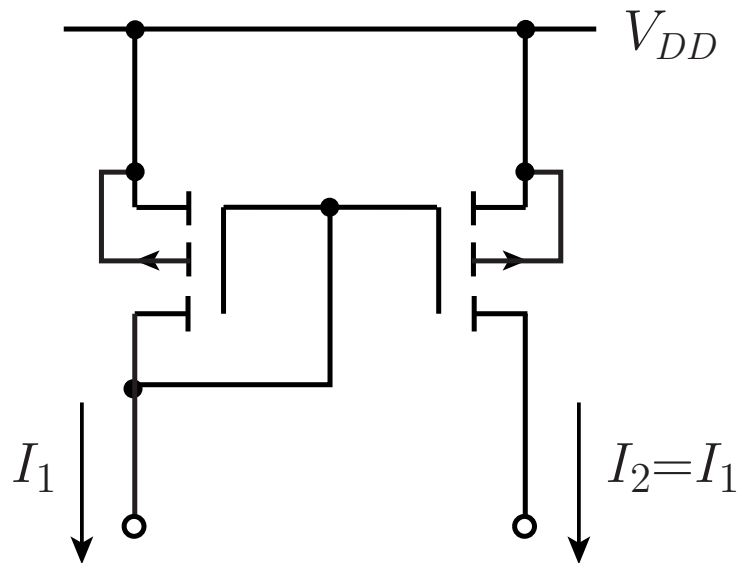


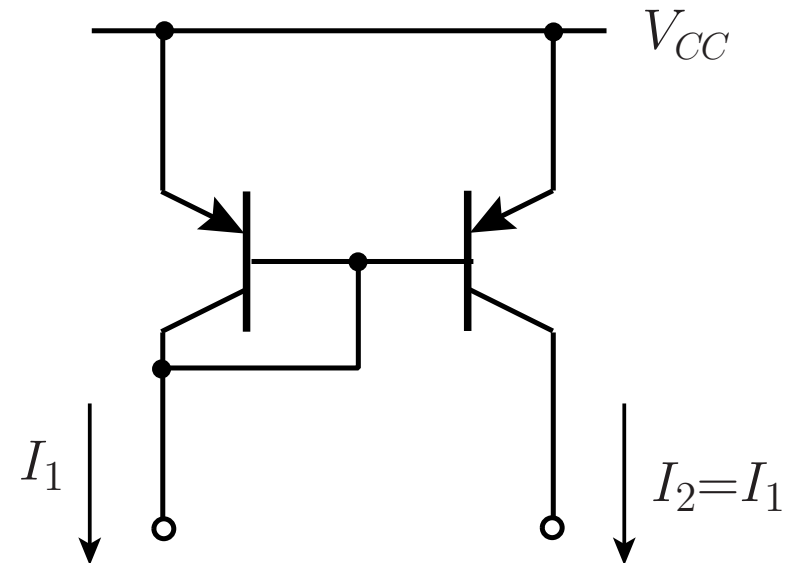
電流の減算

カレントミラー回路



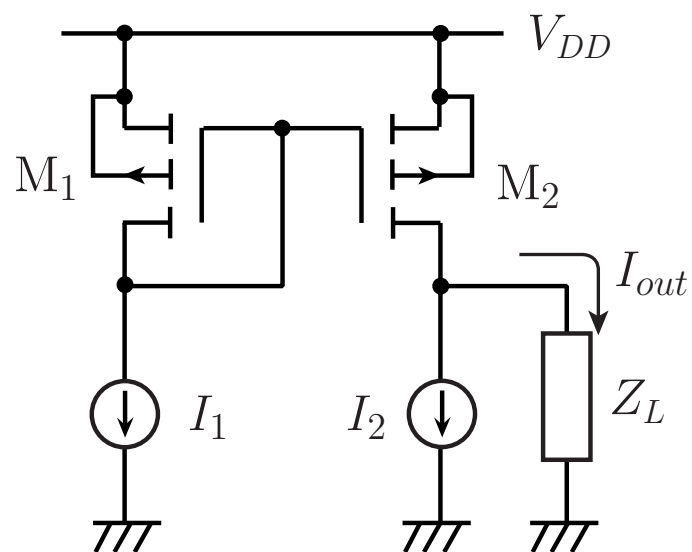
(a)

飽和領域で動作

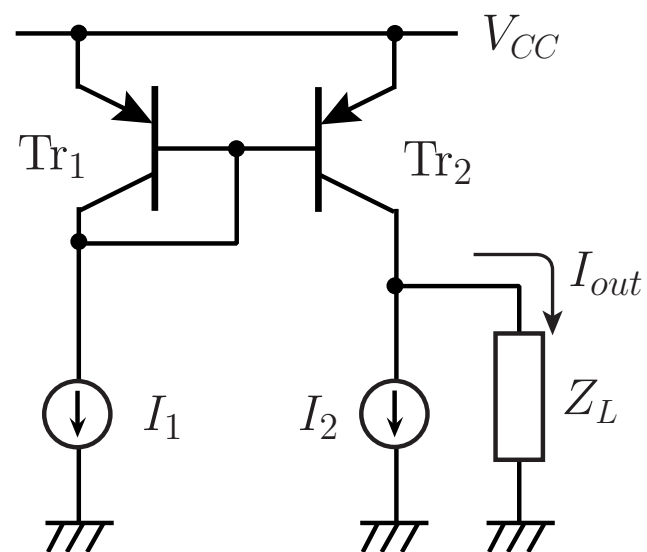


(b)

能動活性領域で動作



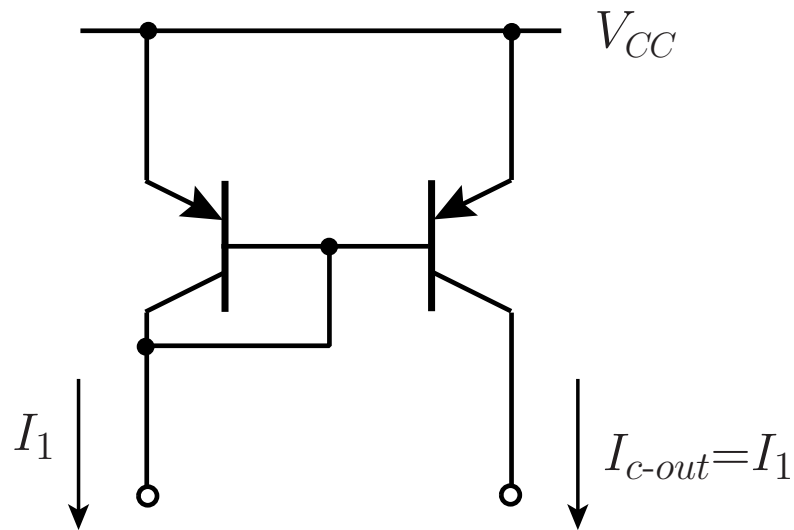
(a)



(b)

$$I_{out} = I_1 - I_2$$

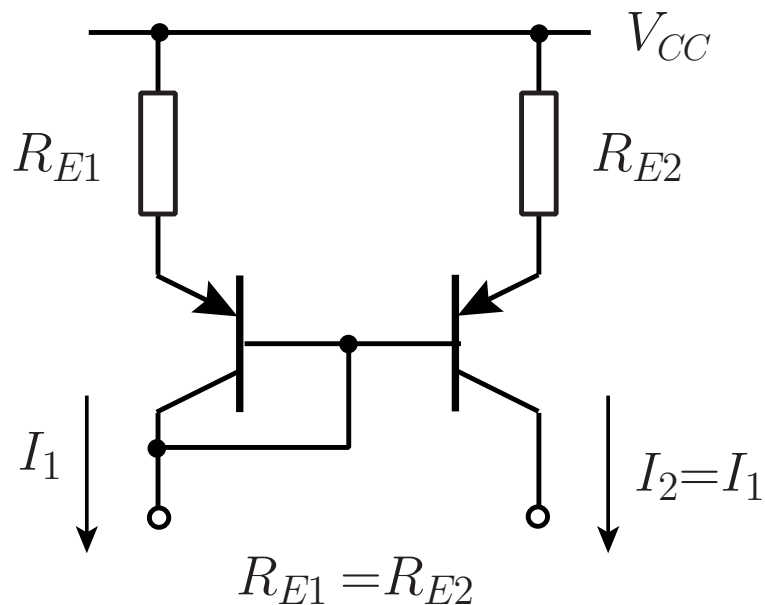
バイポーラ・カレントミラー回路の問題点



ベース・エミッタ間電圧が
等しいので $I_{c-out} = I_1$

$$V_{BE} = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_1}{I_{S1}} + 1\right) = \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_{c-out}}{I_{S2}} + 1\right) \text{ より } I_{c-out} = \frac{I_{S2}}{I_{S1}} I_1$$

I_{S1} と I_{S2} が等しくないと $I_{c-out} \neq I_1$



I_{S1} と I_{S2} の差の影響を
 R_E により吸収

$$R_{E1}I_1 + \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_1}{I_{S1}} + 1\right) = R_{E2}I_2 + \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_2}{I_{S2}} + 1\right)$$

$$R_{E1}I_1 \approx R_{E2}I_2$$

$$R_{E1} = R_{E2} \text{ のとき } I_1 \approx I_2$$

$$R_{E1}I_1 + \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_1}{I_{S1}} + 1\right) = R_{E2}I_2 + \frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_2}{I_{S2}} + 1\right)$$

$$R_E(I_1 - I_2) = -R_E \Delta I = -\frac{kT}{q} \ln\left(\frac{I_{S1}}{I_{S2}} \times \frac{I_2 + I_{S2}}{I_1 + I_{S1}}\right)$$

$$= -\frac{kT}{q} \left(\ln \frac{I_{S1}}{I_{S2}} + \ln \frac{I_1 + \Delta I + I_{S2}}{I_1 + I_{S1}} \right) \text{よ り}$$

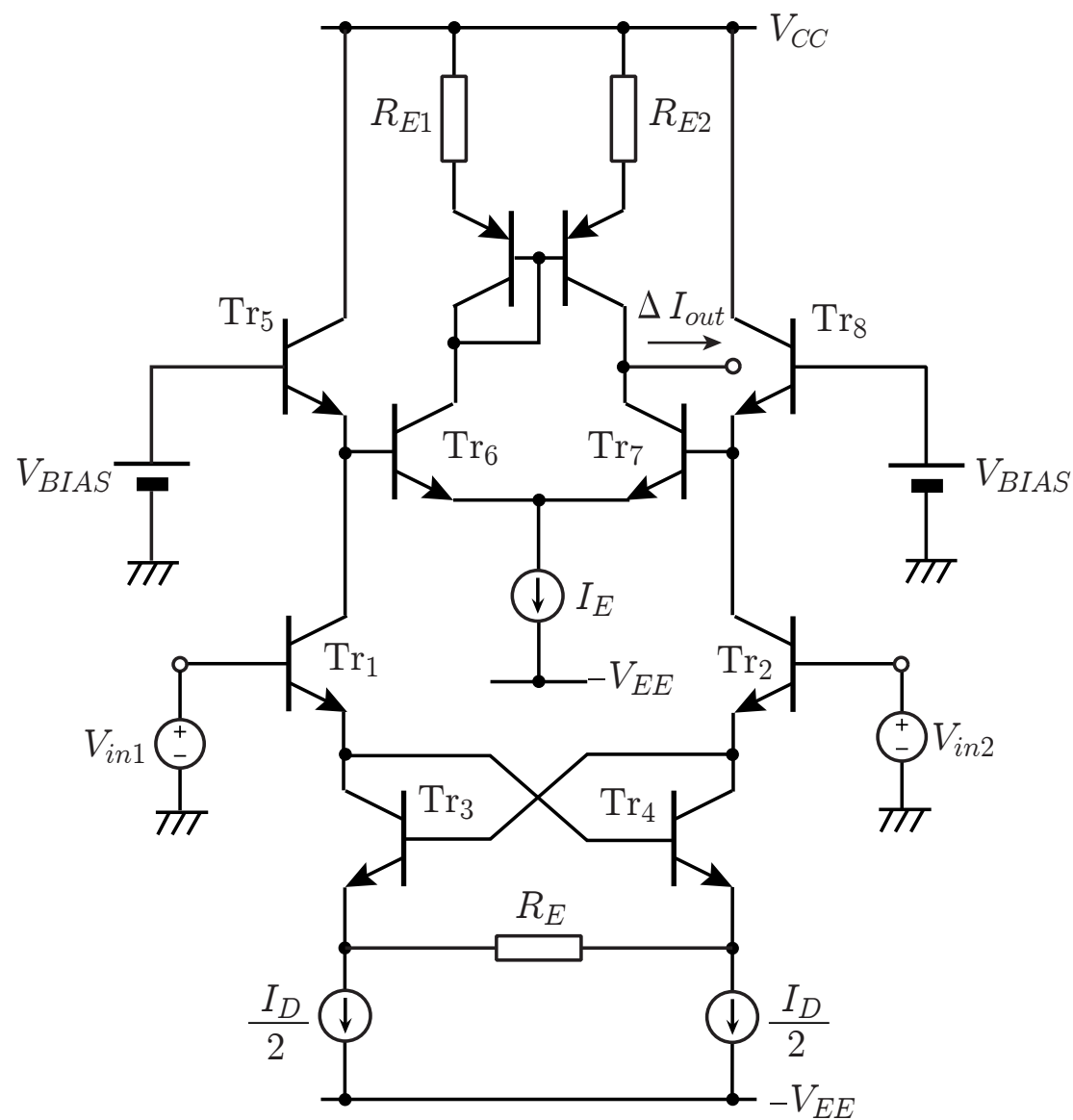
$$\Delta I^{(n+1)} = \frac{kT}{qR_E} \left(\ln \frac{I_{S2}}{I_{S1}} + \ln \frac{I_1 + I_{S1}}{I_1 + \Delta I^{(n)} + I_{S2}} \right)$$

という漸化式が得られる.

$R_{E1} = R_{E2} = 1.0 \text{ k}\Omega$, $I_1 = 1.0 \text{ mA}$, $I_{S1} = 2I_{S2} = 2.0 \text{ fA}$ と仮定する.

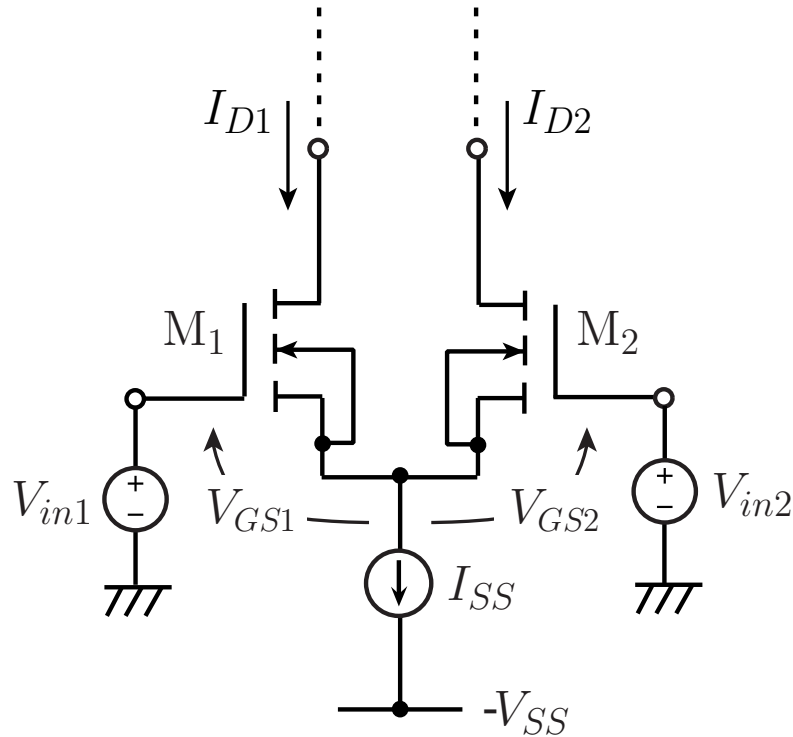
$$\Delta I = -1.747891708 \times 10^{-5} \text{ A}, \quad I_2 = 0.9825210829 \text{ mA}$$

バイポーラトランジスタによる電子的に特性可変のOTA



MOS差動増幅回路の大信号特性

MOS差動増幅回路



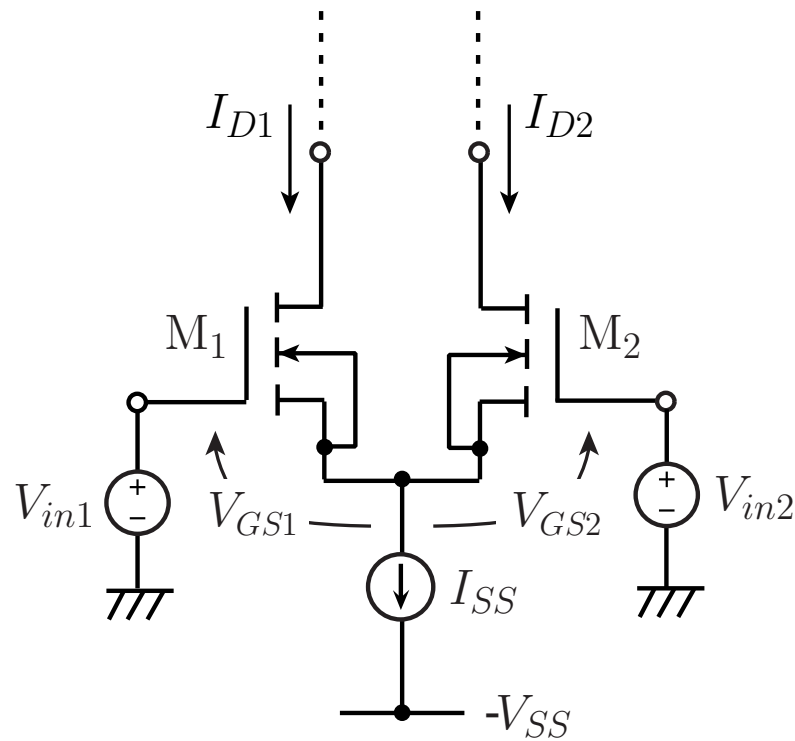
飽和領域： $V_{DS} \geq V_{GS} - V_T > 0$
($V_{SB}=0$ と仮定)

$$2乗則： I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{in1} = \sqrt{\frac{I_{D1}}{K}} + V_S + V_T$$

$$V_{in2} = \sqrt{\frac{I_{D2}}{K}} + V_S + V_T$$

$$\Delta V_{in} = V_{in1} - V_{in2} = \sqrt{\frac{I_{D1}}{K}} - \sqrt{\frac{I_{D2}}{K}}$$



$$\Delta V_{in} = V_{in1} - V_{in2} = \sqrt{\frac{I_{D1}}{K}} - \sqrt{\frac{I_{D2}}{K}}$$

$$\Delta V_{in}^2 = \frac{I_{D1} + I_{D2}}{K} - 2\sqrt{\frac{I_{D1}I_{D2}}{K^2}} = \frac{I_{SS}}{K} - 2\sqrt{\frac{I_{D1}(I_{SS} - I_{D1})}{K^2}}$$

$$I_{D1}^2 - I_{SS}I_{D1} + \frac{K^2}{4}\left(\frac{I_{SS}}{K} - \Delta V_{in}^2\right)^2 = 0$$

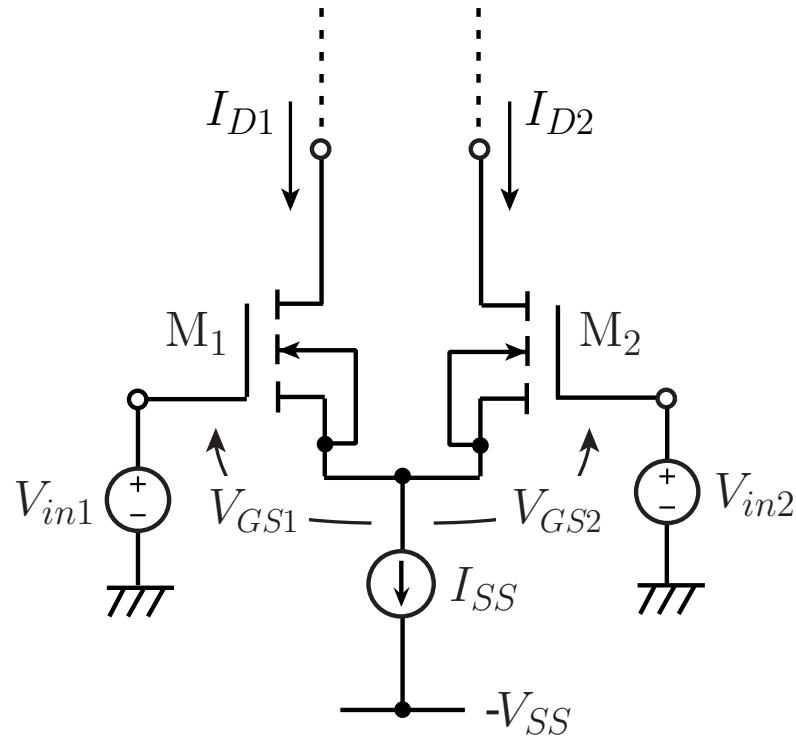
$$I_{D1}^2 - I_{SS}I_{D1} + \frac{K^2}{4} \left(\frac{I_{SS}}{K} - \Delta V_{in}^2 \right)^2 = 0$$

$$I_{D1} = \frac{I_{SS} \pm \sqrt{2KI_{SS}\Delta V_{in}^2 - K^2\Delta V_{in}^4}}{2}$$

$\Delta V_{in} > 0$ のとき $I_{D1} > I_{SS}/2$ より

$$I_{D1} = \frac{I_{SS} + \Delta V_{in} \sqrt{2KI_{SS} - K^2\Delta V_{in}^2}}{2}$$

$$I_{D2} = \frac{I_{SS} - \Delta V_{in} \sqrt{2KI_{SS} - K^2\Delta V_{in}^2}}{2}$$



$$I_{D1} = \frac{I_{SS} + \Delta V_{in} \sqrt{2KI_{SS} - K^2 \Delta V_{in}^2}}{2}$$

$$I_{D2} = \frac{I_{SS} - \Delta V_{in} \sqrt{2KI_{SS} - K^2 \Delta V_{in}^2}}{2}$$

$$\Delta I_{out} = I_{D1} - I_{D2} = \Delta V_{in} \sqrt{2KI_{SS} - K^2 \Delta V_{in}^2}$$

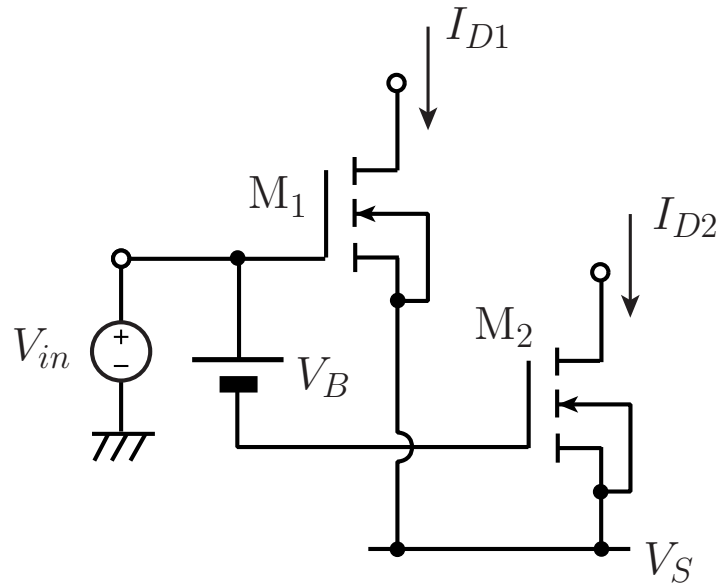
$$|\Delta V_{in}|^2 \ll \sqrt{2I_{SS}/K} \text{ならば}$$

$$\Delta I_{out} = \Delta V_{in} \sqrt{2KI_{SS} - K^2 \Delta V_{in}^2} \approx \sqrt{2KI_{SS}} \Delta V_{in}$$

I_{SS} や K によって線形範囲を拡大可能

I_{SS} や K の値に実質的な制限

バイアスオフセット技術



$$2\text{乗則} : I_D = K(V_{GS} - V_T)^2$$

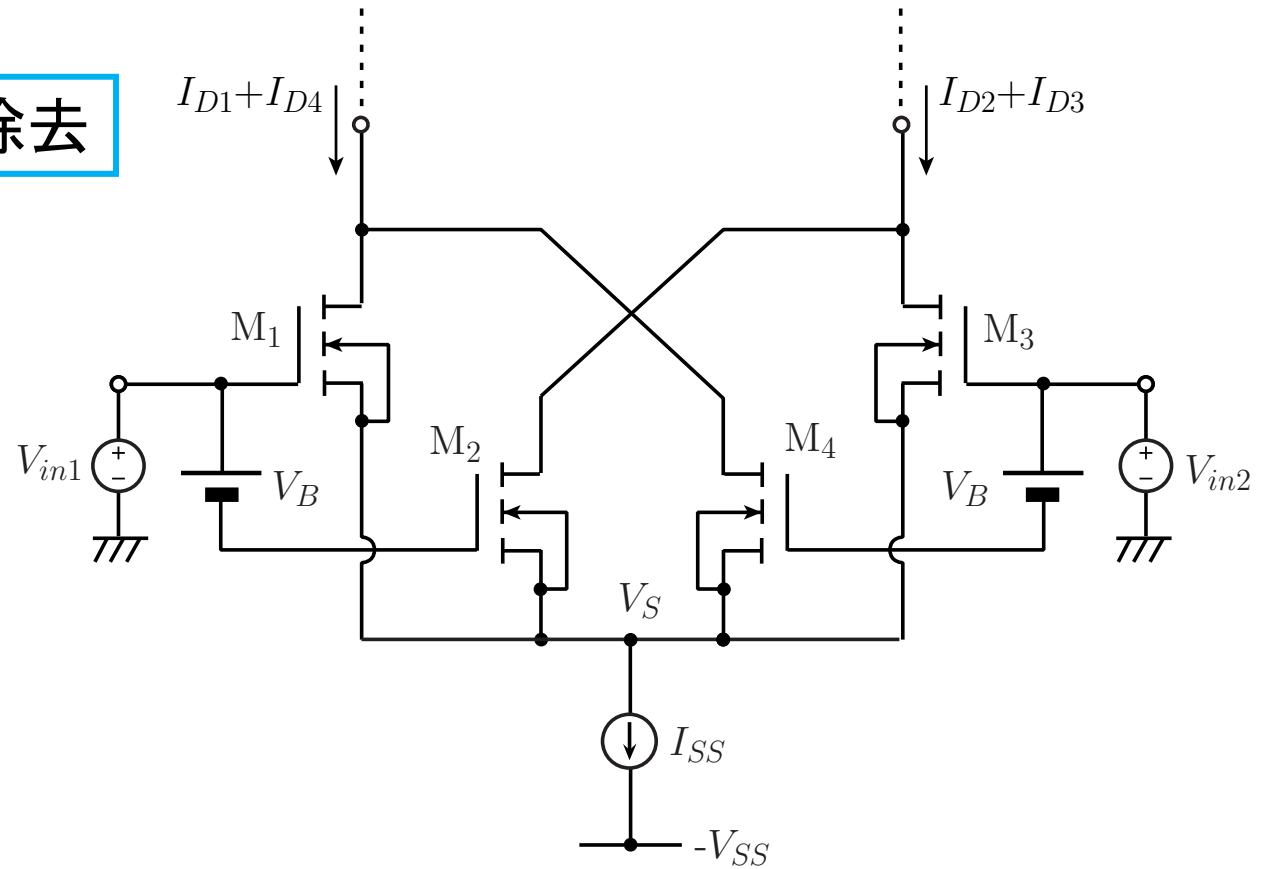
$$I_{D1} = K(V_{in} - V_S - V_T)^2$$

$$I_{D2} = K(V_{in} - V_B - V_S - V_T)^2$$

$$I_{D1} - I_{D2} = K(2V_{in} - V_B - 2V_S - 2V_T)V_B$$

$$= 2KV_BV_{in} - K(V_B + 2V_S + 2V_T)V_B$$

直流電流成分の除去

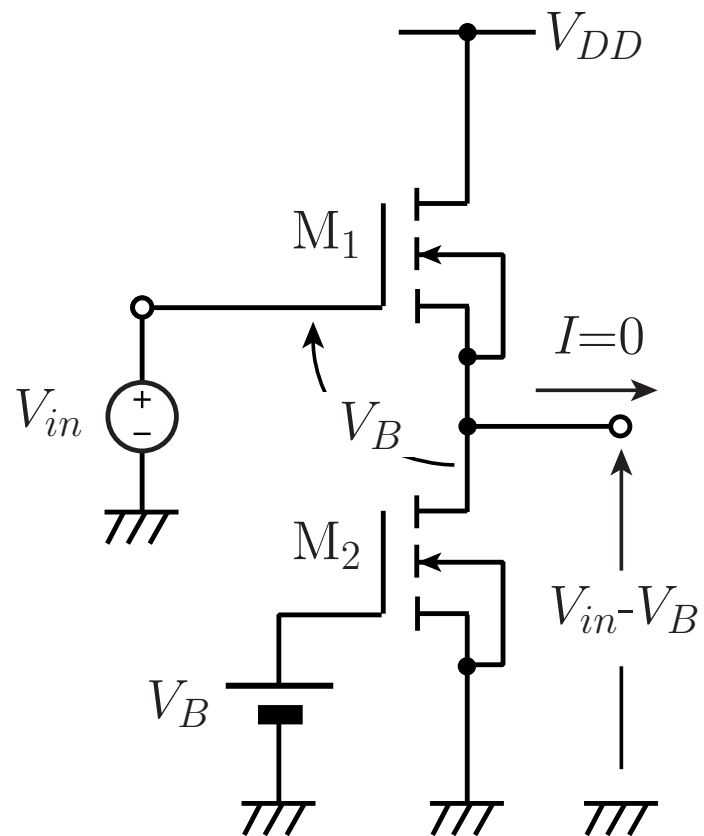


$$I_{D1} - I_{D2} = 2KV_B V_{in1} - K(V_B + 2V_S + 2V_T)V_B$$

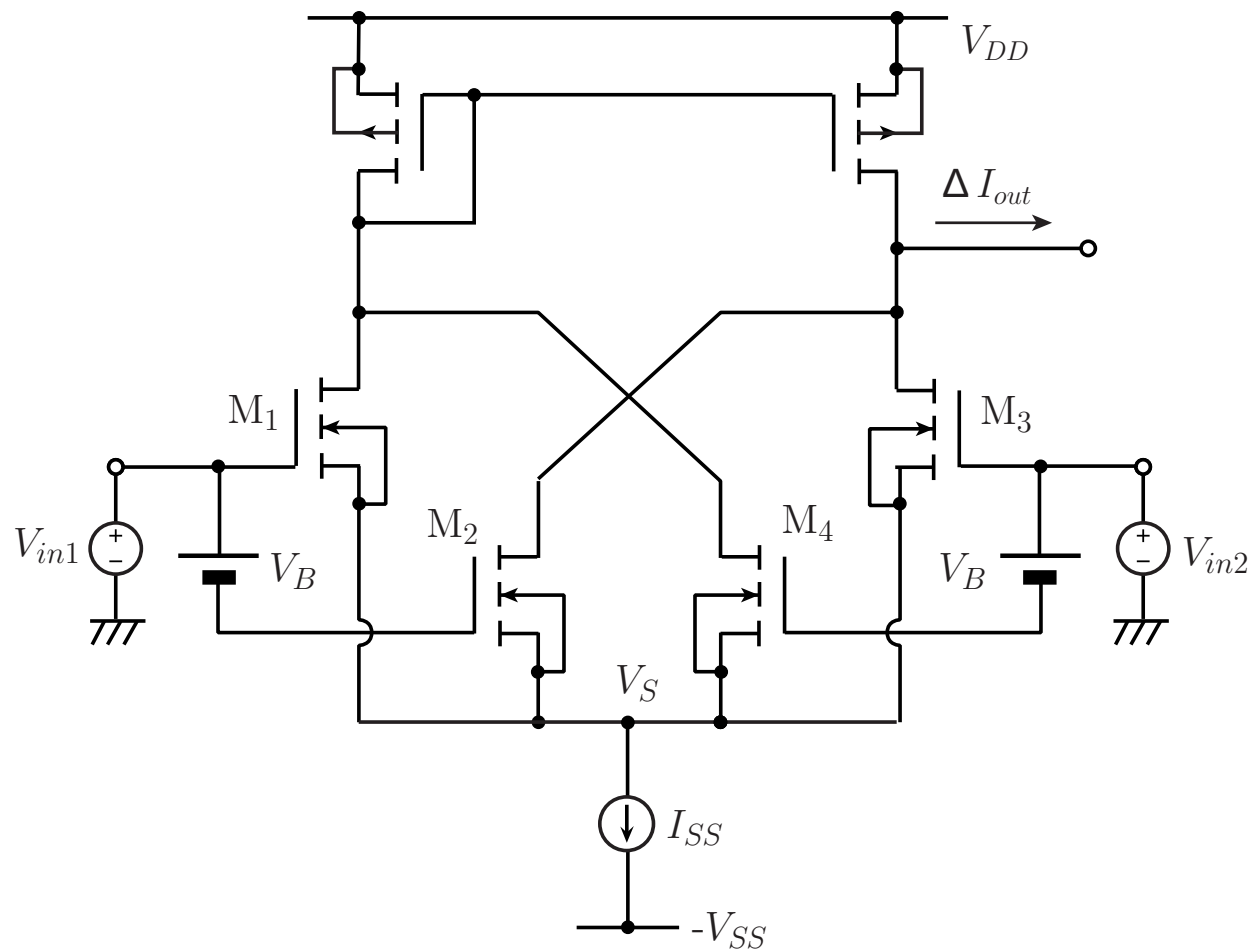
$$I_{D3} - I_{D4} = 2KV_B V_{in2} - K(V_B + 2V_S + 2V_T)V_B$$

$$\Delta I_{out} = (I_{D1} - I_{D2}) - (I_{D3} - I_{D4}) = 2KV_B (V_{in1} - V_{in2})$$

非接地直流電圧源の実現

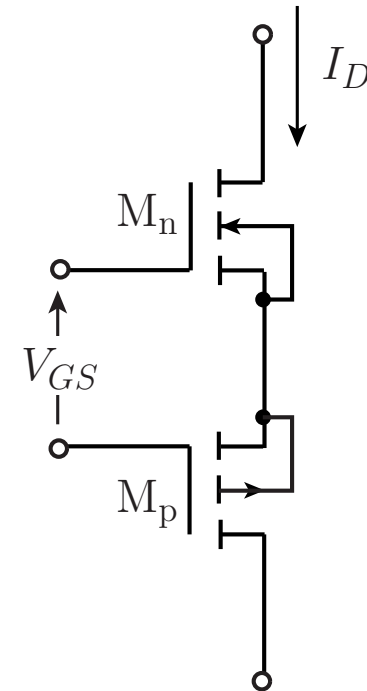
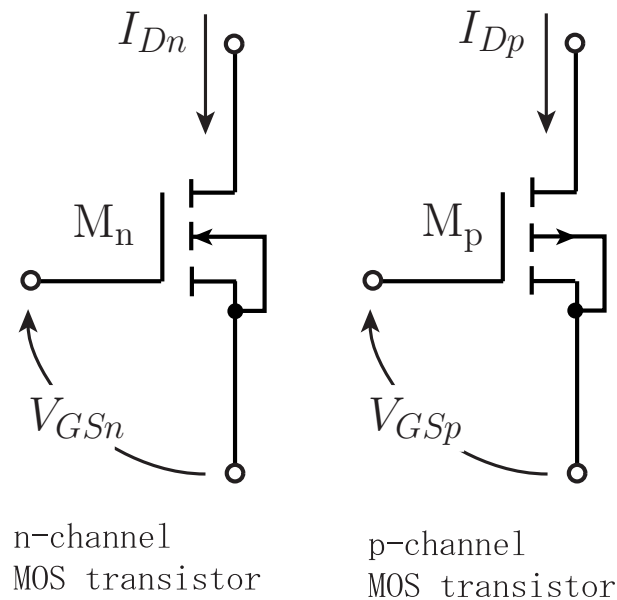


MOSTランジスタによる電子的に特性可変のOTA



$$\Delta I_{out} = (I_{D1} - I_{D2}) - (I_{D3} - I_{D4}) = 2KV_B(V_{in1} - V_{in2})$$

問：CMOSペアの等価ゲート・ソース間電圧 V_{GS} ，
等価コンダクタンスパラメータ K ，等価しきい電圧 V_T を
 K_i ， V_{GSi} ， V_{Ti} ($i=n, p$)を用いて表せ．



CMOSペア

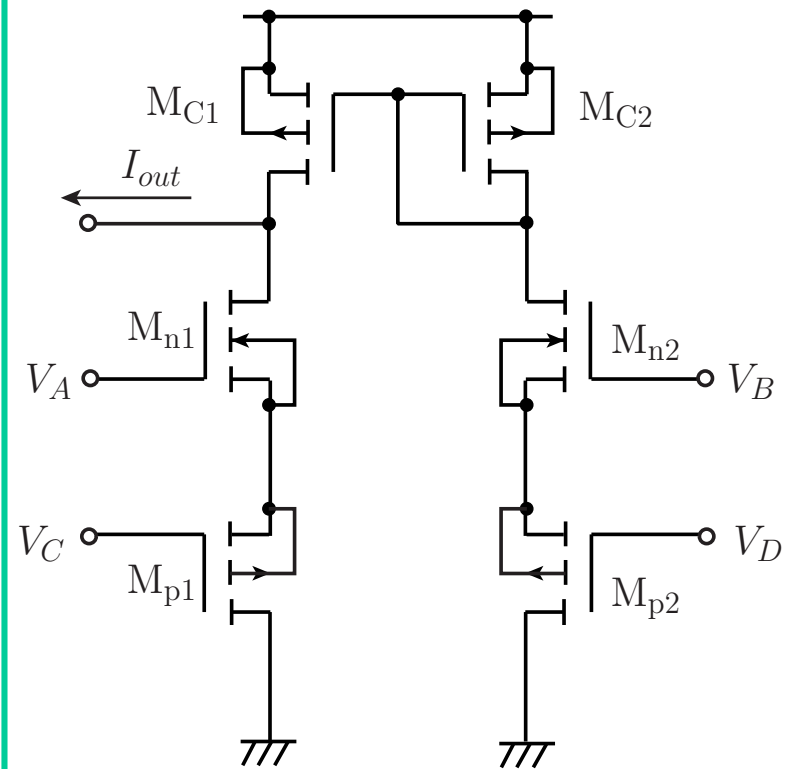
$$I_{Dn} = K_n (V_{GSn} - V_{Tn})^2$$

$$I_{Dp} = -K_p (V_{GSp} - V_{Tp})^2$$

問：右図に示すCMOSペアと
カレントミラー回路から
構成される回路に，適切な電圧
 V_A と V_B ， V_C ， V_D を加え，出力
電流 I_{out} が

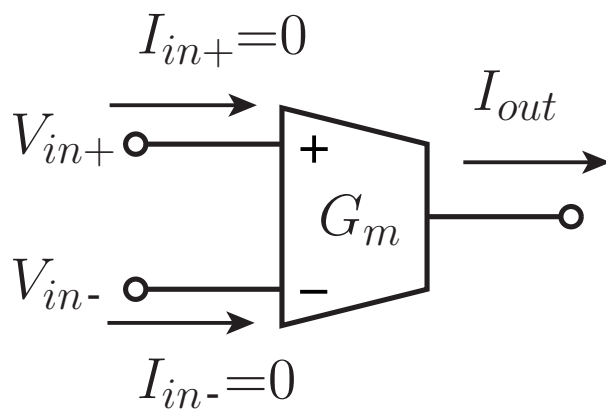
$$I_{out} = \alpha(V_X - V_T)(V_{in1} - V_{in2})$$

となる回路を実現したい．ただし，
 V_{in1} と V_{in2} は入力電圧， α は適当な
定数， V_X は適当な電圧， V_T は
CMOSペアの等価しきい電圧であ
る．電圧 V_A ， V_B ， V_C ， V_D を V_{in1} ，
 V_{in2} ， V_X ， V_T を用いて表せ．また，
 α も求めよ．

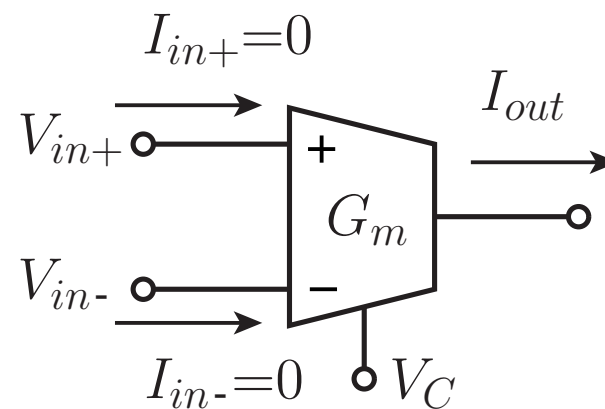


OTAの応用

OTAの記号



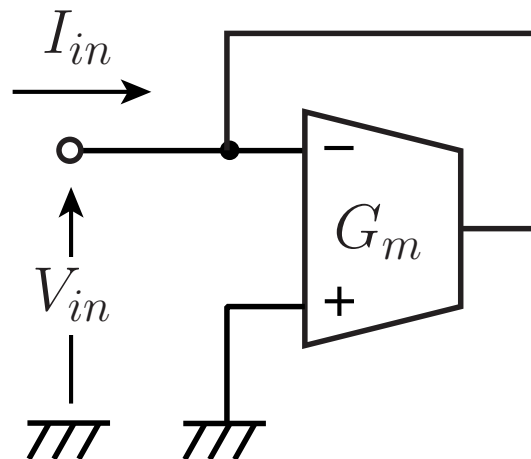
(a)



(b)

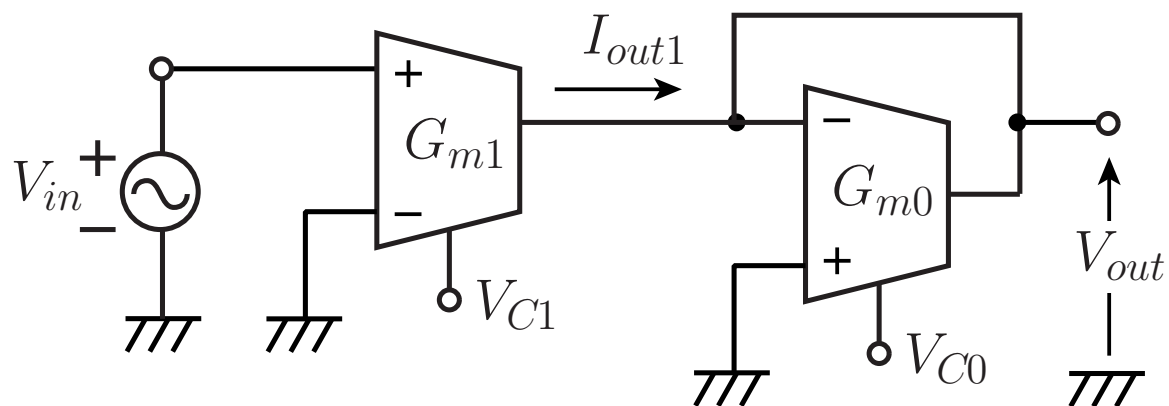
$$I_{out} = G_m (V_{in+} - V_{in-})$$

OTAによる抵抗の構成



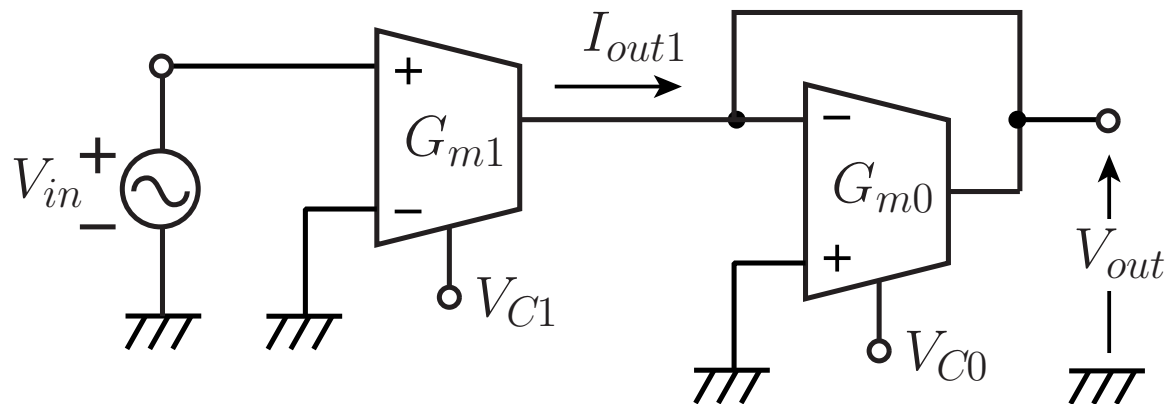
$$I_{in} = G_m V_{in} \rightarrow R_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{1}{G_m}$$

OTAによる増幅回路の構成



$$V_{out} = \frac{1}{G_{m0}} I_{out1} = \frac{G_{m1}}{G_{m0}} V_{in}$$

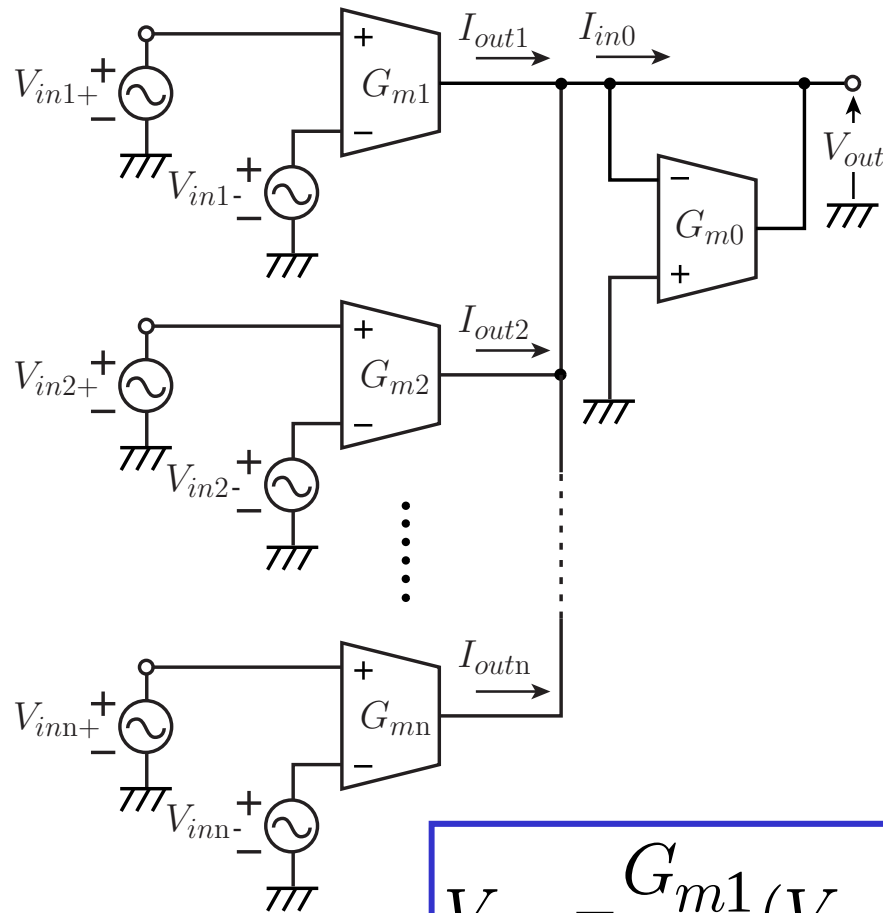
OTAによる乗除算回路の構成



$$G_{m0} = K_{m0} V_{C0}, \quad G_{m1} = K_{m1} V_{C1}$$

$$V_{out} = \frac{G_{m1}}{G_{m0}} V_{in} = \frac{K_{m1}}{K_{m0}} \cdot \frac{V_{C1} V_{in}}{V_{C0}}$$

OTAによる加減算回路の構成



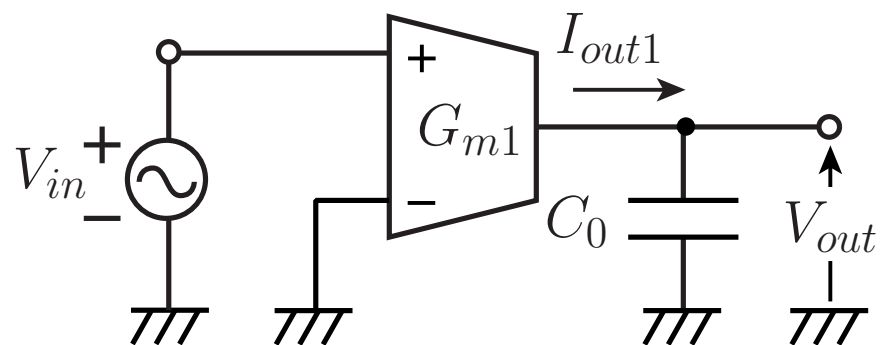
$$I_{in0} = I_{out1} + I_{out2} + \dots + I_{outn}$$

$$I_{outi} = G_{mi}(V_{ini+} - V_{ini-})$$

$$V_{out} = \frac{G_{m1}}{G_{m0}}(V_{in1+} - V_{in1-}) + \frac{G_{m2}}{G_{m0}}(V_{in2+} - V_{in2-}) + \dots$$

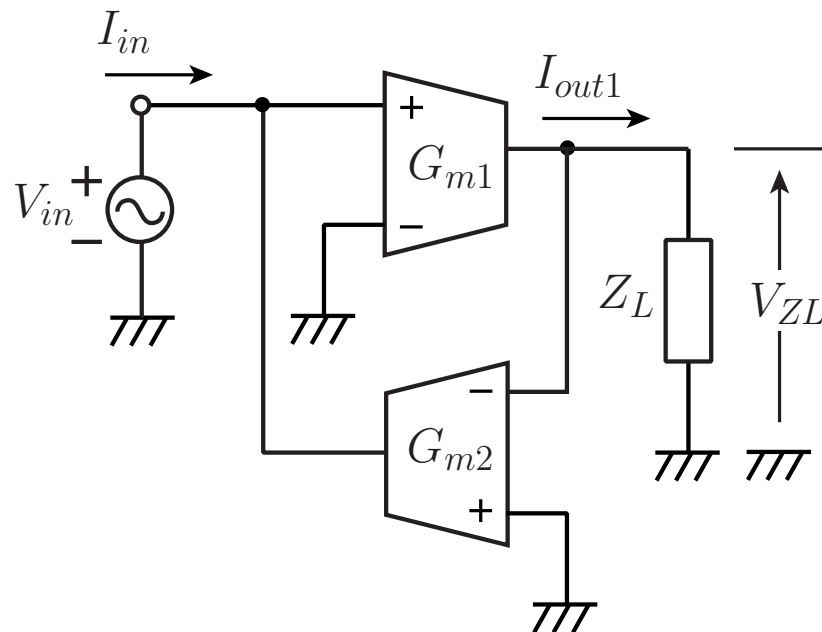
$$\dots + \frac{G_{mn}}{G_{m0}}(V_{inn+} - V_{inn-})$$

OTAによる積分回路の構成



$$V_{out} = \frac{1}{sC_0} I_{out1} = \frac{G_{m1}}{sC_0} V_{in}$$

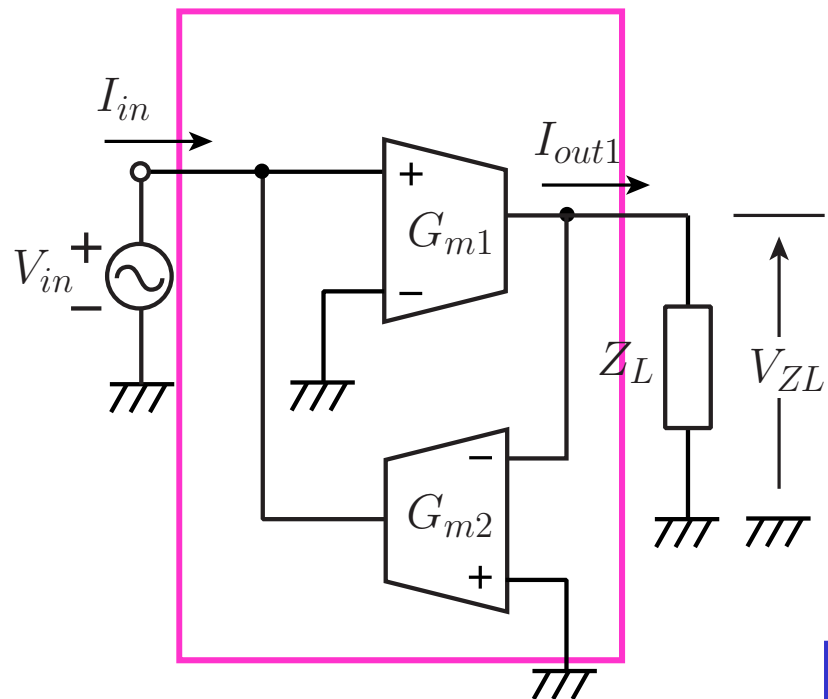
OTAによるインピーダンスの実現



$$V_{ZL} = Z_L I_{out1} = Z_L G_{m1} V_{in}$$

$$I_{in} = G_{m2} V_{ZL}$$

$$Z_{in} = \frac{V_{in}}{I_{in}} = \frac{V_{in}}{G_{m2} V_{ZL}} = \frac{V_{in}}{G_{m2} Z_L G_{m1} V_{in}} = \frac{1}{G_{m2} Z_L G_{m1}}$$



ジャイレータ

$$Z_L = \frac{1}{sC_L}$$

$$Z_{in} = \frac{1}{G_{m2}Z_LG_{m1}} = s \frac{C_L}{G_{m1}G_{m2}}$$

問：下の図の回路の入力インピーダンス $\frac{V_{in}}{I_{in}}$ を求めよ.

